

2SA1287

リレードライブ，電源用
シリコンPNPエピタキシャル形

概要

2SA1287は、樹脂封止形のシリコンPNPエピタキシャル形トランジスタです。耐圧が高い、コレクタ電流、コレクタ損失が大きい、さらに h_{FE} が、一般のものに比べ5~10倍高く設計、製造されていますので、オーディオ機器、VTR、その他電子機器のリレードライブや電源等の汎用高 h_{FE} トランジスタとして、ご使用いただけます。

2SC3247とコンプリメンタリです。

特長

- 高 h_{FE} ($h_{FE}=400\sim1200$)
- コレクタ・エミッタ飽和電圧が小さい
 $V_{CE(sat)}=-0.2V$ (@ $I_C=-500mA, I_B=-10mA$)
- 耐圧が高い $V_{CEO}=-50V$
- コレクタ損失が大きい $P_C=900mW$

用途

オーディオ機器、VTR、その他電子機器のリレードライブや電源

最大定格 ($T_a=25^\circ C$)

記号	項目	定格値	単位
V_{CBO}	コレクタ・ベース間電圧	-50	V
V_{EBO}	エミッタ・ベース間電圧	-6	V
V_{CEO}	コレクタ・エミッタ間電圧	-50	V
I_C	コレクタ電流	-1	A
I_{CM}	せん頭コレクタ電流	-2	A
P_C	コレクタ損失 ($T_a=25^\circ C$)	900	mW
T_j	接合部温度	+150	$^\circ C$
T_{stg}	保存温度	-55~+150	$^\circ C$

電気的特性 ($T_a=25^\circ C$)

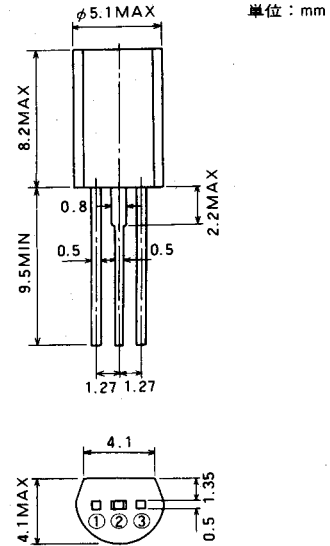
記号	項目	測定条件	特性値			単位
			最小	標準	最大	
$V_{(BR)CBO}$	コレクタ・ベース降伏電圧	$I_C=-10\mu A, I_E=0$	-50			V
$V_{(BR)EBO}$	エミッタ・ベース降伏電圧	$I_E=-10\mu A, I_C=0$	-6			V
$V_{(BR)CEO}$	コレクタ・エミッタ降伏電圧	$I_C=-1mA, R_{BE}=\infty$	-50			V
I_{CBO}	コレクタしや断電流	$V_{CB}=-40V, I_E=0$			-0.1	μA
I_{EBO}	エミッタしや断電流	$V_{EB}=-2V, I_C=0$			-0.1	μA
h_{FE}	↑ 直流電流増幅率	$V_{CE}=-6V, I_C=-0.1A$	400		1800	-
$V_{CE(sat)}$	コレクタ・エミッタ飽和電圧	$I_C=-500mA, I_B=-10mA$		-0.2	-0.5	V
f_T	利得帯域幅積	$V_{CE}=-10V, I_E=10mA$		90		MHz
C_{ob}	コレクタ出力容量	$V_{CB}=-10V, I_E=0, f=1MHz$		30		pF

↑: h_{FE} の値により右表のようにアイテム分類を行っています。

アイテム	G	H	J
h_{FE}	400~800	600~1200	900~1800*

*: 開発中

外形図



電極接続

- ①: エミッタ EIAJ: -
②: コレクタ JEDEC: -
③: ベース

(注1) 公差指定のない寸法は代表値を示す。